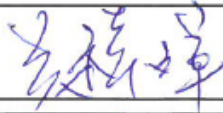


Process Change Notification

ECN/ ECR number	ECN2505-03
Expected Implementation Date	2025.06.02

Description of change :

SMA、SMB、SMC 封裝產品
銅框架與錫膏廠商變更

Department	Department leader	Date
R&D Dept.		2025.6.2
QA Dept.	Michael	2025. 6. 2
Engineering Dept.		2025. 6. 02
Marketing Dept.		2025. 06. 02
Sales Dept.		6/2/25
Customer		

備註：請客戶在 1 個月內完成 REVIEW 並回簽,否則竹懋科技視同客戶同意該變更通知。

產品及製程變更通知

Product / Process Change Notification

PCN 編號(PCN No.) : 2505-03 PCN 等級 : ☐ Class1 ☒ Class2	發行日期(Issue Date) : 2025.06.02
主題 (Subject) : SMA、SMB、SMC 封裝產品銅框架與錫膏廠商變更	
樣品可提供日期 (Samples Availability Date) :	2025.06.02
變更預計生效日期 (Complete Date):	2025.06.02
變更類型(Change Category) : ☐ 材料Material ☐ 外觀Form ☐ 製程Processing/Fit ☐ 規格書Datasheet ☐ 設計Design ☐ 測試Testing ☒ 製造地點Manufacturing Site ☐ 品質/可靠性Quality/Reliability ☐ 包裝/運送/標籤Packing/Shipping/Labeling ☐ 其他Other	
變更敘述(Description of change) : SMA、SMB、SMC 封裝產品銅框架與錫膏廠商變更 (1)銅框架由青島捷本科銳(停止合作)變更為寧波博威(原 second source)。 (2)錫膏由蘇州國通(停止合作)變更為蘇州利福泰/深圳同方(原 second source)。	
變更理由(Reason for Change) : 原second source變更為主要Source。	
產品辨識(Product Identification) : 無	
預期影響(Anticipated impact) : 無	
影響的產品(Affected Product) : SMA、SMB、SMC 封裝產品	
品質驗證(Verification /Qualification) : 請參閱附件	

客戶認可表(Customer Approval Form)

PCN 編號(PCN No.) :	2505-03
請列出產品變更對貴公司應用的影響(Please list affected products for your applications) :	
請確認下列適當的方格打勾(Please check the appropriate box below) :	
☐ 我們同意這提議的變更及計畫表(We agree with this proposed change and the schedule). ☐ 我們不同意這提議的變更及計畫表(We disagree with this proposed change and the schedule). 不同意理由(Reason) :	
☐ 我們需要更多的產品變更的資訊(We need more information about the Product change) :	
☐ 我們需要樣品(We need samples) :	



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司
Chip Integration Technology Corporation

測試日期 Issue Date : 2025/03

產品 Product : SK345AG

包裝形式 Package : SMA

信賴性試驗結果 Reliability Test Result

試驗項目	參考規範	測試條件	測試數量	測試結果 (失效/總數)	判定
Test Item	Ref. Specification	Test Condition	Sample size	Result Fail/Total	Result
高溫逆向偏壓(HTRB)	MIL-STD-750D METHOD-1038	Ta=100℃ ,VBR=36V, Time= 168hrs	22	0/22	Pass
High Temperature Revers Bias					
順向浪湧(F.surge)	MIL-STD-750D METHOD-4066-2	70A,8.3ms single half sine-wave	22	0/22	Pass
Forward Surge Current					
靜電試驗 (ESD)	IEC 61000-4-2	8KV,INTERVAL:1S,contact disharge 10 Cycles	10	0/10	Pass
ElectroStatic Discharge					
逆向浪湧 (R. surge)	-	1A,PULSE WIDTH : 2us , PERIOD : 998us	22	0/22	Pass
Revere Surge Current					

APPROVED BY : DH

PREPARED BY : Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

Reverse Surge Test Data

測試條件及規範： 1A,PULSE WIDTH：2us，PERIOD：998us

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK345AG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 45
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 45 IR-L(uA)=
SSG6000 VF-H(mV)= 550 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	506	51.27	4.80	513	51.13	4.00	
2	512	51.47	4.10	519	51.36	3.30	
3	514	51.67	3.70	518	51.58	3.10	
4	519	53.82	3.70	525	53.68	2.80	
5	518	53.12	3.60	523	53.00	2.90	
6	508	50.94	4.50	510	50.79	3.70	
7	519	51.87	3.50	526	51.72	2.60	
8	512	51.42	4.10	519	51.30	3.20	
9	506	52.17	5.30	513	51.99	4.30	
10	514	51.47	4.00	518	51.35	3.20	
11	498	50.71	6.70	502	50.62	5.40	
12	513	53.59	4.30	517	53.48	3.50	
13	517	52.12	3.90	519	52.03	3.30	
14	505	51.16	5.50	507	51.00	4.40	
15	519	52.41	3.50	521	52.33	3.00	
16	515	52.61	3.80	518	52.51	3.10	
17	513	49.11	4.20	518	49.05	3.40	
18	512	50.91	4.10	516	50.79	3.30	
19	517	51.61	3.80	519	51.50	3.10	
20	514	52.56	4.00	518	52.48	3.40	
21	516	52.23	3.70	521	52.13	3.00	
22	519	52.30	3.50	521	52.25	3.20	
MAX	519	53.8	6.70	526	53.7	5.40	
MIN	498	49.1	3.50	502	49.1	2.60	
AVG	513	51.8	4.20	517	51.7	3.42	
STD	5	1.0	0.78	6	1.0	0.63	

APPROVED BY：

DH

PREPARED BY：

Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

Forward Surge Test Data

測試條件及規範： 70A,8.3ms single half sine-wave ,MIL-STD-750D METHOD-4066-2

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK345AG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 45
 測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 45 IR-L(uA)=
 PIF8000 VF-H(mV)= 550 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	520	53.12	3.90	524	52.14	2.80	
2	509	50.64	4.30	526	50.52	3.30	
3	500	50.83	6.80	505	50.64	4.90	
4	511	53.08	5.10	528	52.89	3.70	
5	515	52.00	4.10	525	51.79	3.10	
6	519	52.36	3.80	524	52.15	2.90	
7	518	52.57	3.90	524	52.30	3.00	
8	516	52.35	4.30	527	50.58	3.40	
9	498	52.43	7.70	510	52.29	6.10	
10	515	51.91	4.30	524	51.70	3.00	
11	507	52.32	6.20	511	52.17	4.70	
12	514	54.01	4.90	519	53.79	3.40	
13	506	51.93	6.40	511	51.78	5.00	
14	518	52.06	4.50	530	51.83	3.00	
15	517	52.50	3.80	524	52.35	3.00	
16	516	54.48	4.50	521	54.34	3.60	
17	509	51.96	5.30	516	51.90	4.10	
18	513	53.23	5.00	514	53.08	4.00	
19	509	52.07	5.30	517	51.93	4.10	
20	515	52.33	4.50	523	52.10	3.10	
21	519	52.55	3.70	525	52.41	2.90	
22	507	52.40	5.40	524	52.26	4.20	
MAX	520	54.5	7.70	530	54.3	6.10	
MIN	498	50.6	3.70	505	50.5	2.80	
AVG	512	52.4	4.90	521	52.1	3.70	
STD	6	0.9	1.07	7	0.9	0.86	

APPROVED BY :

DH

PREPARED BY :

Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

ESD Test Data

測試條件及規範： 8KV,INTERVAL:1S, contact discharge,IEC 61000-4-210 Cycles

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK345AG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 45
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 45 IR-L(uA)=
ESS-2002EX VF-H(mV)= 550 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	520	50.5	4.40	510	50.6	4.60	
2	526	53.4	3.00	523	53.5	3.20	
3	522	51.5	3.30	518	51.5	3.40	
4	522	51.7	3.00	521	51.8	3.50	
5	522	51.0	3.60	522	51.0	3.80	
6	515	50.5	3.90	511	50.6	4.20	
7	524	52.9	3.30	518	52.9	3.50	
8	507	50.9	4.50	508	50.8	4.50	
9	506	51.9	4.70	508	51.9	4.70	
10	525	51.8	3.00	525	51.8	3.00	
MAX	526	53	5	525	53	5	
MIN	506	51	3	508	51	3	
AVG	519	52	4	516	52	4	
STD	6.07	1.09	0.59	5.88	1.09	0.53	

APPROVED BY : DH

PREPARED BY : Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

HTRB Test Data

測試條件及規範： VR= 36V rate at Ta= 100℃,Time= 168 hrs,MIL-STD-750D METHOD-1038

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK345AG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 45
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 45 IR-L(uA)=
VF-H(mV)= 550 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	507	50.44	3.70	504	50.62	5.50	
2	524	54.27	2.50	521	54.53	3.80	
3	512	51.28	3.60	514	51.70	4.50	
4	517	51.46	3.00	509	51.42	5.00	
5	512	51.09	3.40	509	51.27	4.60	
6	518	51.00	2.80	516	51.16	3.80	
7	519	51.73	2.60	516	51.90	3.60	
8	520	53.25	2.80	517	53.44	3.80	
9	503	51.97	4.60	501	52.12	6.20	
10	519	52.24	2.70	516	52.47	4.10	
11	517	51.41	2.80	514	51.64	4.30	
12	522	52.41	2.50	518	52.63	3.90	
13	518	52.02	2.60	514	52.25	4.10	
14	518	52.36	2.80	514	52.59	4.30	
15	521	51.97	2.90	519	52.08	3.50	
16	518	52.49	2.80	515	52.68	4.20	
17	512	51.97	3.50	509	52.18	5.00	
18	515	51.56	3.10	512	51.75	4.50	
19	521	52.27	2.90	520	52.38	3.50	
20	515	52.80	3.40	513	52.95	4.40	
21	503	52.13	6.60	503	52.11	6.10	
22	517	52.57	4.10	517	52.56	4.00	
MAX	524	54.3	6.60	521	54.5	6.20	
MIN	503	50.4	2.50	501	50.6	3.50	
AVG	516	52.0	3.26	513	52.2	4.40	
STD	6	0.8	0.92	5	0.8	0.76	

APPROVED BY : _____ DH

PREPARED BY : _____ Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司
Chip Integration Technology Corporation

測試日期 Issue Date : 2025/04

產品 Product : SK56BG

包裝形式 Package : SMB

信賴性試驗結果 Reliability Test Result

試驗項目	參考規範	測試條件	測試數量	測試結果 (失效/總數)	判定
Test Item	Ref. Specification	Test Condition	Sample size	Result Fail/Total	Result
高溫逆向偏壓(HTRB)	MIL-STD-750D METHOD-1038	Ta=100℃ ,VBR=48V, Time= 168hrs	22	0/22	Pass
High Temperature Revers Bias					
順向浪湧(F.surge)	MIL-STD-750D METHOD-4066-2	100A,8.3ms single half sine-wave	22	0/22	Pass
Forward Surge Current					
靜電試驗 (ESD)	IEC 61000-4-2	8KV,INTERVAL:1S,contact disharge 10 Cycles	10	0/10	Pass
ElectroStatic Discharge					
逆向浪湧 (R. surge)	-	1A,PULSE WIDTH : 2us , PERIOD : 998us	22	0/22	Pass
Revere Surge Current					

APPROVED BY : DH

PREPARED BY : Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

Reverse Surge Test Data

測試條件及規範： 1A,PULSE WIDTH：2us，PERIOD：998us

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK56BG IF(A)= 5 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
SSG6000 VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	652	72.30	8.00	654	72.33	8.50	
2	658	73.10	7.50	652	73.16	7.90	
3	654	71.80	7.60	648	71.92	8.10	
4	662	72.50	7.90	648	72.64	8.30	
5	655	73.20	7.70	658	73.18	8.10	
6	644	71.10	8.90	643	71.16	9.50	
7	658	74.50	6.80	661	74.67	7.70	
8	647	73.10	8.90	648	73.19	9.70	
9	645	73.40	8.90	645	73.47	9.50	
10	658	75.20	8.60	653	75.40	9.20	
11	658	75.60	7.90	658	75.65	8.30	
12	659	75.40	8.80	664	75.46	9.20	
13	660	75.60	8.20	662	75.69	8.60	
14	649	73.70	9.30	646	73.74	9.50	
15	660	75.40	7.10	667	75.45	7.30	
16	660	75.70	8.50	656	75.72	8.80	
17	660	74.40	7.50	657	74.43	7.50	
18	660	76.00	8.00	665	76.11	8.10	
19	668	75.00	7.00	661	75.05	7.10	
20	663	75.50	7.80	660	75.55	8.00	
21	647	70.90	9.30	642	70.90	9.60	
22	656	75.90	8.80	656	75.92	9.10	
MAX	668	76.0	9.30	667	76.1	9.70	
MIN	644	70.9	6.80	642	70.9	7.10	
AVG	656	74.1	8.14	655	74.1	8.53	
STD	6	1.6	0.74	7	1.6	0.80	

APPROVED BY：

DH

PREPARED BY：

Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

Forward Surge Test Data

測試條件及規範： 100A,8.3ms single half sine-wave ,MIL-STD-750D METHOD-4066-2

晶粒廠商 CITC 批號： 產品： SK56BG IF(A)= 5 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
PIF8000 VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	646	72.90	9.60	645	72.95	9.40	
2	646	72.80	9.20	645	72.87	9.00	
3	650	73.70	9.30	646	73.71	9.20	
4	653	74.00	8.00	653	74.02	7.90	
5	642	73.50	10.90	641	73.51	10.50	
6	647	73.40	10.30	646	73.44	9.50	
7	662	76.00	8.00	660	76.00	7.40	
8	646	73.00	9.70	645	73.06	9.40	
9	649	72.90	8.70	651	72.93	8.40	
10	648	73.40	10.20	644	73.38	9.60	
11	655	75.70	9.20	659	75.70	8.30	
12	653	75.40	9.40	653	75.36	8.60	
13	658	74.50	7.80	662	74.50	7.40	
14	653	72.20	7.50	655	72.23	7.00	
15	646	72.90	9.50	647	72.99	9.00	
16	660	75.90	8.30	662	75.88	7.70	
17	653	75.30	9.10	653	75.33	8.50	
18	648	73.50	9.70	648	73.47	9.10	
19	657	75.50	8.70	659	75.52	7.80	
20	661	75.90	8.50	659	75.87	8.00	
21	647	73.00	9.90	644	73.01	9.20	
22	648	72.40	9.10	648	72.42	8.50	
MAX	662	76.0	10.90	662	76.0	10.50	
MIN	642	72.2	7.50	641	72.2	7.00	
AVG	651	74.0	9.12	651	74.0	8.61	
STD	6	1.3	0.87	7	1.3	0.87	

APPROVED BY :

DH

PREPARED BY :

Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

ESD Test Data

測試條件及規範： 8KV,INTERVAL:1S, contact discharge,IEC 61000-4-210 Cycles

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK56BG IF(A)= 5 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
ESS-2002EX VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	663	75.7	8.30	660	75.8	7.90	
2	659	73.9	7.30	660	73.9	6.90	
3	652	73.7	9.10	644	73.7	8.50	
4	664	74.9	8.10	655	75.0	7.70	
5	650	72.2	8.20	652	72.2	7.90	
6	659	75.3	8.00	656	75.3	7.70	
7	659	75.9	8.20	660	75.9	7.70	
8	650	72.7	8.30	649	72.7	8.10	
9	652	73.5	9.90	646	73.4	9.60	
10	647	72.6	9.70	643	72.6	9.60	
MAX	664	76	10	660	76	10	
MIN	647	72	7	643	72	7	
AVG	656	74	9	653	74	8	
STD	5.99	1.34	0.81	6.70	1.36	0.86	

APPROVED BY : DH

PREPARED BY : Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

HTRB Test Data

測試條件及規範： VR= 48V rate at Ta= 100℃,Time= 168hrs,MIL-STD-750D METHOD-1038

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK56BG IF(A)= 5 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
 測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
 VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	656	74.54	6.20	656	74.62	6.70	
2	653	73.65	6.40	653	73.76	7.00	
3	640	70.98	8.00	640	70.94	8.10	
4	640	70.35	7.60	640	70.34	7.80	
5	653	75.63	7.90	652	75.70	7.90	
6	643	73.62	8.10	643	73.62	8.30	
7	644	72.69	7.60	643	72.70	7.80	
8	650	72.45	6.40	650	72.54	6.80	
9	644	73.15	7.20	644	73.32	7.50	
10	643	73.59	8.50	643	73.66	9.00	
11	655	75.45	6.90	655	75.67	7.70	
12	644	73.00	8.00	644	73.12	8.80	
13	642	72.82	8.00	643	72.97	9.40	
14	650	72.27	6.30	649	72.58	7.00	
15	647	72.70	7.00	647	72.84	7.90	
16	657	75.54	6.60	657	75.68	7.20	
17	645	73.02	7.70	645	73.21	8.70	
18	650	75.16	7.80	650	75.43	8.80	
19	648	70.80	6.10	648	70.86	6.50	
20	646	72.54	7.30	645	72.64	8.10	
21	655	75.70	7.20	655	75.85	7.70	
22	641	73.56	8.80	641	73.71	10.90	
MAX	657	75.7	8.80	657	75.9	10.90	
MIN	640	70.4	6.10	640	70.3	6.50	
AVG	648	73.3	7.35	647	73.4	7.98	
STD	5	1.5	0.78	5	1.6	1.02	

APPROVED BY : _____ DH

PREPARED BY : _____ Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司
Chip Integration Technology Corporation

測試日期 Issue Date : 2025/02

產品 Product : SK36CG

包裝形式 Package : SMC

信賴性試驗結果 Reliability Test Result

試驗項目	參考規範	測試條件	測試數量	測試結果 (失效/總數)	判定
Test Item	Ref. Specification	Test Condition	Sample size	Result Fail/Total	Result
高溫逆向偏壓(HTRB)	MIL-STD-750D METHOD-1038	Ta=100℃ ,VBR=48V, Time= 168hrs	22	0/22	Pass
High Temperature Revers Bias					
順向浪湧(F.surge)	MIL-STD-750D METHOD-4066-2	70A,8.3ms single half sine-wave	22	0/22	Pass
Forward Surge Current					
靜電試驗 (ESD)	IEC 61000-4-2	8KV,INTERVAL:1S,contact disharge 10 Cycles	10	0/10	Pass
ElectroStatic Discharge					
逆向浪湧 (R. surge)	-	1A,PULSE WIDTH : 2us , PERIOD : 998us	22	0/22	Pass
Revere Surge Current					

APPROVED BY : DH

PREPARED BY : Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

Reverse Surge Test Data

測試條件及規範： 1A,PULSE WIDTH：2us，PERIOD：998us

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK36CG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
SSG6000 VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	634	69.34	3.70	633	69.45	4.40	
2	636	70.41	3.60	640	70.50	4.10	
3	637	70.05	4.20	631	70.06	4.40	
4	636	69.31	3.50	636	69.34	3.80	
5	631	69.78	4.10	633	69.84	4.30	
6	634	70.45	3.70	634	70.50	4.00	
7	642	69.58	3.60	633	69.62	4.00	
8	639	71.35	3.80	636	71.39	4.00	
9	635	69.44	3.60	635	69.49	3.80	
10	637	70.10	3.90	634	70.15	4.10	
11	633	70.92	3.90	636	70.95	4.10	
12	638	70.40	3.70	637	70.47	3.90	
13	634	69.31	3.60	630	69.38	3.90	
14	637	69.94	3.60	636	69.97	3.80	
15	630	69.46	3.90	630	69.47	4.10	
16	640	71.71	3.70	637	71.74	3.90	
17	634	70.53	4.00	636	70.56	4.10	
18	641	74.14	3.90	640	74.19	4.20	
19	635	69.62	3.70	640	69.66	3.90	
20	637	71.07	3.70	642	71.10	3.80	
21	639	70.62	3.90	635	70.64	3.90	
22	632	69.61	4.10	630	69.63	4.30	
MAX	642	74.1	4.20	642	74.2	4.40	
MIN	630	69.3	3.50	630	69.3	3.80	
AVG	636	70.3	3.79	635	70.4	4.04	
STD	3	1.1	0.19	3	1.1	0.19	

APPROVED BY : _____ DH

PREPARED BY : _____ Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

Forward Surge Test Data

測試條件及規範： 70A,8.3ms single half sine-wave ,MIL-STD-750D METHOD-4066-2

晶粒廠商 CITC 批號： 產品： SK36CG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
PIF8000 VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	635	71.08	3.90	634	71.14	4.20	
2	632	69.18	4.20	636	69.24	4.40	
3	634	69.46	3.70	632	69.49	4.00	
4	632	69.91	4.20	635	69.90	4.10	
5	629	70.14	4.10	636	70.12	4.00	
6	634	69.16	3.90	631	69.16	3.90	
7	639	70.17	4.00	632	70.17	4.10	
8	635	69.74	4.10	636	69.77	4.20	
9	632	69.73	4.70	630	69.73	4.70	
10	633	69.96	4.10	633	69.98	4.10	
11	632	70.27	4.10	634	70.29	4.10	
12	624	72.32	4.70	624	72.32	4.60	
13	631	69.36	4.10	632	69.36	4.00	
14	632	69.50	4.10	634	69.50	4.00	
15	629	69.60	4.40	638	69.57	4.40	
16	633	69.28	4.20	633	69.42	4.20	
17	632	69.14	4.30	634	69.15	4.40	
18	630	70.21	4.20	634	70.23	4.30	
19	631	70.12	4.30	633	70.11	4.20	
20	636	70.37	4.00	637	70.39	4.10	
21	630	69.10	3.90	637	69.12	4.10	
22	632	71.01	4.10	635	71.02	4.30	
MAX	639	72.3	4.70	638	72.3	4.70	
MIN	624	69.1	3.70	624	69.1	3.90	
AVG	632	69.9	4.15	634	70.0	4.20	
STD	3	0.8	0.24	3	0.8	0.20	

APPROVED BY :

DH

PREPARED BY :

Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

ESD Test Data

測試條件及規範： 8KV,INTERVAL:1S, contact discharge,IEC 61000-4-210 Cycles

晶粒廠商 CITC 批號： 產品：SK36CG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
ESS-2002EX VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	635	69.5	3.80	631	69.5	3.90	
2	635	69.3	4.10	634	69.3	4.30	
3	631	69.8	4.40	631	69.8	4.50	
4	630	69.6	4.20	633	69.7	4.20	
5	635	69.9	4.10	634	70.0	4.30	
6	636	70.1	3.70	636	70.1	4.00	
7	631	69.8	4.10	630	69.8	4.00	
8	636	72.3	4.10	636	72.3	4.00	
9	634	69.2	3.80	638	69.2	3.80	
10	632	69.5	4.00	634	69.6	4.10	
MAX	636	72	4	638	72	5	
MIN	630	69	4	630	69	4	
AVG	634	70	4	634	70	4	
STD	2.27	0.90	0.21	2.54	0.89	0.21	

APPROVED BY : DH

PREPARED BY : Penny



竹 懋 科 技 股 份 有 限 公 司

HTRB Test Data

測試條件及規範： VR= 48V rate at Ta=100 °C, Time= 168 hrs, MIL-STD-750D METHOD-1038

晶粒廠商 CITC 批號： 產品： SK36CG IF(A)= 3 IR(mA)= 0.5 VR(V)= 60
測試機台 TVR6000 刻號： VF-L(mV)= VB-L(V)= 60 IR-L(uA)=
VF-H(mV)= 700 VB-H(V)= IR-H(uA)= 500

NO.	Initial Data			After Data			
	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	VF(mV)	VB(V)	IR(uA)	
1	635	69.15	3.80	635	69.10	3.80	
2	626	68.92	4.20	626	68.89	4.00	
3	631	69.92	3.90	631	69.90	3.80	
4	631	69.87	3.90	631	69.84	3.70	
5	635	71.38	3.80	635	71.38	3.70	
6	631	70.49	4.00	631	70.51	4.00	
7	631	69.84	3.70	631	69.82	3.70	
8	627	69.59	4.40	627	69.63	4.70	
9	629	70.03	4.00	629	70.05	4.10	
10	629	69.48	3.90	629	69.52	4.10	
11	629	70.18	3.90	629	70.19	3.80	
12	627	69.66	3.90	628	69.67	4.00	
13	628	70.19	3.90	628	70.23	4.00	
14	633	70.51	3.70	633	70.56	4.00	
15	630	69.52	3.80	630	69.55	4.00	
16	625	69.19	4.30	625	69.16	4.50	
17	630	70.45	7.30	630	70.49	7.50	
18	629	69.95	4.10	629	69.97	4.20	
19	631	71.16	4.00	631	71.22	4.40	
20	628	70.07	4.20	628	70.13	4.60	
21	628	69.70	4.50	628	69.75	4.70	
22	626	69.37	4.50	626	69.44	4.90	
MAX	635	71.4	7.30	635	71.4	7.50	
MIN	625	68.9	3.70	625	68.9	3.70	
AVG	630	69.9	4.17	630	70.0	4.28	
STD	3	0.6	0.74	3	0.6	0.80	

APPROVED BY : _____ DH

PREPARED BY : _____ Penny